**Лошкарев, Иван Дмитриевич. Напряженное состояние и дислокационная структура пленок GaAs, GaP и GeSi на кремнии : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07 / Лошкарев Иван Дмитриевич; [Место защиты: Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН].- Новосибирск, 2013.- 135 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-1/982**